



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-106225

(43)Date of publication of application : 20.04.1999

(51)Int.Cl.

C03B 20/00
C03C 15/00

(21)Application number : 09-282757

(71)Applicant : SHINETSU QUARTZ PROD CO
LTD

(22)Date of filing : 30.09.1997

(72)Inventor : INAGI KYOICHI
SEGAWA TORU

(54) QUARTZ GLASS HAVING DEPRESSIONS AND PROJECTIONS ON SURFACE AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a quartz glass member used for treating semiconductors, excellent in adhesivity to an oxidized film formed in a CVD process, not contaminating the semiconductor products with particles and impure elements and easy in cleansing by forming spherical or ovally spherical depressions and projections having diameters of a specific value or less on the surface of the quartz glass.

SOLUTION: This quartz glass has spherical or ovally spherical depressions and projections having diameters of $\leq 10 \mu\text{m}$ on a part or all parts of the surface of the quartz glass, and does not have a microcrack. The depressions and the projections preferably exit on the quartz glass in a rate of ≥ 10000 depressions and projections per mm^2 of the quartz glass. The quartz glass is produced by forming a $\leq 100 \mu\text{m}$ -thick thin film on the surface of the quartz glass, and subsequently etching the quartz glass with a HF solution or an atmosphere containing fluorine. A substance for forming the thin film is especially not limited, but preferably is an organic substance, especially an organic compound containing at least one of oxygen, nitrogen, phosphorus, silicon, fluorine and metal atoms or their mixtures in the molecule.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

18.02.2003

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than
the examiner's decision of rejection or
application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

DERWENT-ACC-NO: 1999-307962

DERWENT-WEEK: 200238

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Quartz glass for semiconductor device
manufacture - has spherical or ellipsoidal roughness of specific
diameter
on surface

PATENT-ASSIGNEE: SHINETSU SEKIEI KK[SHINN] , SHINETSU QUARTZ PROD
CO
LTD[SHINN]

PRIORITY-DATA: 1997JP-0282757 (September 30, 1997) , 1997JP-0314577
(October
31, 1997)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE
PAGES MAIN-IPC		
JP 11106225 A	April 20, 1999	N/A
005 C03B 020/00		
KR 304338 B	November 2, 2001	N/A
000 H01L 021/00		
KR 99028186 A	April 15, 1999	N/A
000 H01L 021/00		
TW 438731 A	June 7, 2001	N/A
000 C03C 015/00		

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO
APPL-DATE		
JP 11106225A	N/A	1997JP-0282757
September 30, 1997		
KR 304338B	N/A	1997KR-0071442
December 20, 1997		
KR 304338B	Previous Publ.	KR 99028186
N/A		
KR 99028186A	N/A	1997KR-0071442
December 20, 1997		
TW 438731A	N/A	1997TW-0118251
December 4, 1997		

INT-CL (IPC): C03B020/00, C03C015/00 , H01L021/00

RELATED-ACC-NO: 1999-352592

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 11106225A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - The glass has spherical or ellipsoidal roughness of 10 μ m or less diameter on the surface.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for manufacture of quartz glass.

USE - For semiconductor device.

ADVANTAGE - The glass excels in adhesion of oxide film such as silicon dioxide due to provision of spherical or ellipsoidal roughness. As the glass has no cracks, contamination by impurities is prevented. Cleaning of glass is performed with ease.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/2

TITLE-TERMS: QUARTZ GLASS SEMICONDUCTOR DEVICE MANUFACTURE SPHERE
ELLIPSOID
ROUGH SPECIFIC DIAMETER SURFACE

DERWENT-CLASS: L01 L03 U11 U13

CPI-CODES: L01-A05; L04-C22;

EPI-CODES: U11-A05B; U11-C01J8; U13-D07;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1999-090783

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1999-231116

PAT-NO: JP411106225A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 11106225 A

TITLE: QUARTZ GLASS HAVING DEPRESSIONS AND
PROJECTIONS ON SURFACE AND ITS PRODUCTION

PUBN-DATE: April 20, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
INAGI, KYOICHI	N/A
SEGAWA, TORU	N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
SHINETSU QUARTZ PROD CO LTD	N/A

APPL-NO: JP09282757

APPL-DATE: September 30, 1997

INT-CL (IPC): C03B020/00, C03C015/00

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a quartz glass member used for treating semiconductors, excellent in adhesivity to an oxidized film formed in a CVD process, not contaminating the semiconductor products with particles and impure elements and easy in cleansing by forming spherical or ovally spherical depressions and projections having diameters of a specific value or less on the surface of the quartz glass.

SOLUTION: This quartz glass has spherical or ovally spherical depressions and projections having diameters of $\leq 10 \mu\text{m}$ on a part or all parts of the surface of the quartz glass, and does not have a microcrack. The

depressions
and the projections preferably exit on the quartz glass in a rate of
>10000
depressions and projections per mm² of the quartz glass. The quartz
glass is
produced by forming a <100 μm-thick thin film on the surface of
the
quartz glass, and subsequently etching the quartz glass with a HF
solution or
an atmosphere containing fluorine. A substance for forming the thin
film is
especially not limited, but preferably is an organic substance,
especially an
organic compound containing at least one of oxygen, nitrogen,
phosphorus,
silicon, fluorine and metal atoms or their mixtures in the molecule.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

【特許請求の範囲】

【請求項1】表面に凹凸を有する石英ガラスであって、前記凹凸が直径10 μ m以下の球状または楕円球状であることを特徴とする表面に凹凸を有する石英ガラス。

【請求項2】球状または楕円球状の凹凸を少なくとも10000ヶ/mm²有することを特徴とする請求項1記載の表面に凹凸を有する石英ガラス。

【請求項3】石英ガラス表面にマイクロクラックが存在しないことを特徴とする請求項1又は2記載の表面に凹凸を有する石英ガラス。

【請求項4】石英ガラス表面に100 μ m以下の薄膜を形成したのち、エッチング処理することを特徴とする表面に凹凸を有する石英ガラスの製造方法。

【請求項5】薄膜が有機物質からなる薄膜であることを特徴とする請求項4記載の表面に凹凸を有する石英ガラスの製造方法。

【請求項6】有機物質が分子中に酸素、リン、珪素、フッ素、窒素または金属の各原子の少なくとも1つを有する有機化合物またはそれらの混合物であることを特徴とする請求項5記載の表面に凹凸を有する石英ガラスの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、表面に凹凸を有する石英ガラスおよびその製造方法、さらに詳しくは表面に微細な凹凸を有する半導体工業用石英ガラスおよびその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】従来、半導体素子の製造には高純度で、比較的耐熱性が高く、しかも耐薬品性の高い石英ガラス製治具が広く使われている。そして前記治具の表面には意識的に凹凸を設けることが多く、例えば実公昭61-88233号公報には内面が凹凸面にされたLPCVD用炉心管が、また、特開平1-170019号公報にはウエハー載置溝の表面がサンドブラストで凸部が形成されたウエハー載置用ポートがそれぞれ記載されている。こうした石英ガラス表面の凹凸は、いわゆるフロスト処理で形成するのが一般的であるが、フロスト処理は結晶質二酸化珪素粉を吹き付け、石英ガラス表面を削り取る処理であるところから、凹凸の形成とともにマイクロクラックが発生し、石英ガラスの赤外線散乱反射率を変化させるばかりでなく、その後のHF溶液によるエッチング処理で、マイクロクラックが選択的にエッチングされて粗面化され、そこにエッチング処理液が付着したり、或はパーティクルが発生し、半導体製品を汚染する等の問題があった。また、フロスト処理で得た石英ガラスは、その凹凸が大きく半導体素子製造におけるCVD工程で形成する二酸化珪素膜などの酸化膜との密着性が悪く剥離し易いなどの欠点もあった。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】こうした現状に鑑み、本発明者等は鋭意研究を重ねた結果、石英ガラス表面に10 μ m以下の球状または楕円球状の凹凸を有し、マイクロクラックの発生がない石英ガラスを用いて作成した半導体処理用部材は、半導体製品を不純物元素やパーティクルで汚染することのなく、しかも半導体製造のCVD工程で形成する酸化膜との密着性に優れ熱サイクルにおいても剥離しにくいことを見出した。そして前記表面に凹凸を有する石英ガラスはその表面に100 μ m以下の薄膜を形成し、それをHF溶液またはフッ素を含有する雰囲気などでエッチング処理することで容易に製造できることを見出し、本発明を完成したものである。すなわち

【0004】本発明は、表面に球状または楕円球状の凹凸を有し、マイクロクラックのない石英ガラスを提供することを目的とする。

【0005】また、本発明は、CVD工程で形成される酸化膜との密着性に優れ、パーティクルや不純物元素による半導体製品の汚染がなく、かつ洗浄が容易な半導体処理用石英ガラス部材を提供することを目的とする。

【0006】さらに、本発明は、上記石英ガラスの製造方法を提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発明は、表面に凹凸を有する石英ガラスであって、前記凹凸が直径10 μ m以下の球状または楕円球状である表面に凹凸を有する石英ガラスおよびその製造方法に係る。

【0008】本発明の石英ガラスは、例えば炉芯管、ウエハー載置用ポート等、半導体工業で使用される治具に代表される部材の素材として有用で、その表面の一部又は全部に直径10 μ m以下の球状または楕円球状の凹凸を有し、マイクロクラックのない石英ガラスである。より好ましくは前記凹凸が10000ヶ/mm²以上存在する石英ガラスがよい。このように直径10 μ m以下の球状または楕円球状の凹凸が10000ヶ/mm²以上存在することで、二酸化珪素膜など熱膨張係数の異なる酸化膜もCVD工程で密着性よく石英ガラス表面に形成されても、熱サイクルの加熱、冷却によっても剥離することが少ない。また、マイクロクラックの発生がないところから、マイクロクラックに基づく赤外線散乱反射率の変化が起ることがない上に、マイクロクラックに付着した不純物元素や該マイクロクラックに起因するパーティクルによる汚染がなく、しかも洗浄が容易である。前記石英ガラスの表面の凹凸が球状または楕円球状であるところから、長時間のエッチング処理でも凹凸が殆ど変化せず、仮令エッチング処理で球状同志の境界部分が鋭くともなっても、全体として表面状態が殆ど変ることがない。前記直径10 μ m以下の球状または楕円球状の凹凸とは、石英ガラス表面のすべての凹凸の内、50%以上が直径10 μ m以下の球状または楕円球状であることを

いう。前記凹凸の直径が $10\mu\text{m}$ を超える凹凸は石英ガラス表面に形成する薄膜の分子サイズを大きくする必要があり、使用できる薄膜が限定される上に、表面粗さが粗くなり、二酸化珪素などの酸化膜の密着性に劣り熱サイクルで酸化膜の剥離が起る。また、直径が $10\mu\text{m}$ を超える球状または楕円球状の凹凸を $10000\text{ヶ}/\text{mm}^2$ 以上形成することは困難である。

【0009】上記本発明の石英ガラスは、石英ガラス表面に $100\mu\text{m}$ 以下の薄膜を形成したのちHF溶液またはフッ素を含有する雰囲気などでエッチング処理すること10とて製造できる。前記エッチング処理としては、フッ酸溶液によるエッチング処理やプラズマエッチング処理などが挙げられる。また、薄膜を形成する物質としては石英ガラス表面に $100\mu\text{m}$ 以下の薄膜を形成できる物質であれば無機物質でもまた有機物質でもよく特に制限されないが、好ましくは有機物質からなる薄膜がよい。有機物質としては分子中に酸素、窒素、リン、珪素、フッ素または金属の各原子を少なくとも1つ有する有機化合物またはその混合物が好ましく使用でき、具体的には、アルコール類、フェノール類、アルデヒド類、ケトン20類、カルボン酸類、アミン類、有機珪素化合物、有機ハロゲン化合物、有機金属化合物またはそれらの誘導体およびそれらの混合物などが挙げられる。特にシリコン、グリセリン、脂肪酸およびその誘導体、フッ素樹脂、クロロフルオロカーボン、フッ素ゴムなどが好適に使用される。

【0010】本発明の石英ガラスの製造方法の一例を以下に示す。すなわち、石英ガラス表面に薄膜を形成する物質をスピンナー、バーコーター、アプリケーションター、カーテンフローなどの塗布手段を用いて膜厚 $100\mu\text{m}$ 30以下、好ましくは $0.1\sim 10\mu\text{m}$ に塗布し、乾燥したのちHF溶液またはフッ素を含有する雰囲気などでエッチング処理することからなる製造方法である。前記製造方法で薄膜の膜厚が $100\mu\text{m}$ を超えるとHF溶液またはフッ素を含有する雰囲気などでエッチング処理で薄膜が剥離せず、薄膜の形成された部分がエッチングされずに残り、球状または楕円球状の凹凸を形成できない上に、エッチングムラも発生して好ましくない。また、薄膜が $0.1\mu\text{m}$ 未満ではHF溶液またはフッ素を含有する雰囲気などでエッチング処理で薄膜が短時間に剥離し、石英ガラス表面に凹凸が生じない。好適なエッチング条件としては、例えば5%HF溶液で30分、26%HF溶液で10分程度の処理がよいが、薄膜が厚い場合にはエッチング処理時間を長くする必要がある。また、フッ素を含有する雰囲気としては SF_6 、 NF_3 などが挙げられる。

【0011】上記HF溶液またはフッ素を含有する雰囲気などでエッチング処理で石英ガラス表面に球状または楕円球状の凹凸が形成されるのは、薄膜が形成されている部分のエッチングが抑制されるが、薄膜が薄い場合に

は薄膜の分子形状に沿ってHF溶液またはフッ素を含有する雰囲気浸透しガラス表面を部分的にエッチングすることに起因するものと考えられる。したがって、薄膜が厚い場合にはHF溶液またはフッ素を含有する雰囲気浸透が石英ガラス表面まで浸透することができないので球状または楕円球状の凹凸の形成が困難となる。

【0012】

【発明の実施の形態】次に本発明の実施例について述べるがこれによって本発明はなんら限定されるものではない。

【0013】

【実施例】

実施例1

石鹸水のはいった槽に、石英ガラスチューブを沈め、回転したのち引上げて乾燥した。石英ガラス表面には $1\mu\text{m}$ の薄膜が形成されていた。前記石英ガラスチューブを5%HF溶液で120分のエッチングしたところ、表面に図1にみるように直径 $0.5\sim 3\mu\text{m}$ の球状もしくは楕円球状の凹凸が約 $40000\text{ヶ}/\text{mm}^2$ 形成されていた。この石英ガラスチューブ表面に SiH_4 を原料として、 600°C のCVD工程で PolySi 膜を $20\mu\text{m}$ の厚さに形成した。この石英ガラスチューブについて室温から 600°C までの加熱・冷却サイクル処理を30回行ったのち、目視による観察をしたところ、 PolySi 膜に剥離やマイクロクラックの発生が確認できなかった。

【0014】実施例2

石英ガラスチューブにシリコンオイルを刷毛で塗布したのち高速で回転して、余分のシリコンオイルを吹き飛ばし膜厚 $6\mu\text{m}$ のシリコンオイル膜を形成した。前記石英ガラスチューブを25%HF溶液で60分のエッチング処理したところ、その表面には図2にみるような直径 $1\sim 8\mu\text{m}$ の球状もしくは楕円球状の凹凸が約 $80000\text{ヶ}/\text{mm}^2$ 形成されていた。この石英ガラス表面に SiH_4 を原料として、 600°C のCVD工程で PolySi 膜を $20\mu\text{m}$ の厚さに形成し、それに室温から 600°C までの加熱・冷却サイクル処理を30回施した。処理後の石英ガラスチューブについて目視による観察を行ったが、 PolySi 膜の剥離やマイクロクラックの発生が確認できなかった。

【0015】比較例1

グリセリンを石英ガラスチューブ表面に噴霧器で塗布して膜厚 $500\mu\text{m}$ のグリセリン膜を形成した。前記石英ガラスチューブを5%HF溶液で120分のエッチング処理をしたところ、石英ガラス表面には、まだらな白濁が形成されただけで、凹凸の形成がなかった。また、前記石英ガラスチューブ表面に SiH_4 を原料として、 600°C のCVD工程で PolySi 膜を $20\mu\text{m}$ の厚さに形成し、室温から 600°C までの加熱・冷却サイクル処理を30回施したところ、 PolySi 膜にはマイク

(4)

特開平11-106225

5

ロクラックが発生し、さらにPolySi膜の一部に剥離があった。

【0016】比較例2

石英ガラスチューブ表面にSiH₄を原料として、600°CのCVD工程でPolySi膜を20μm厚さに形成し、それを室温から600°Cまでの加熱・冷却サイクル処理を30回施したところ、PolySi膜にマイクロクラックが発生し、PolySi膜の一部に剥離があった。

【0017】

【発明の効果】本発明の石英ガラスは、表面に微細な球状または楕円球状の凹凸が均一に形成され、マイクロ

6

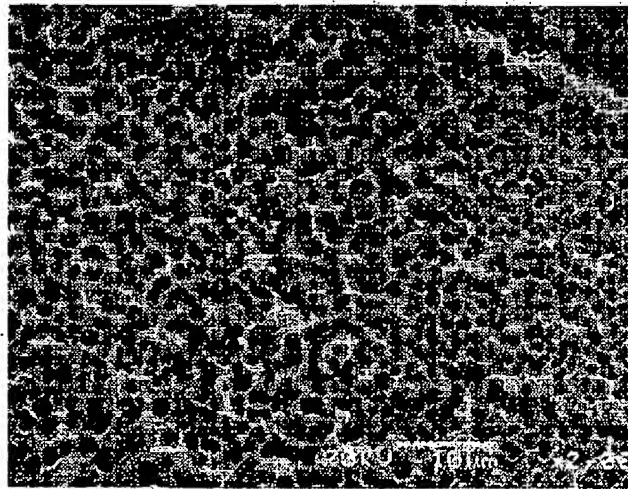
クラックのない石英ガラスである。この石英ガラスで作成した半導体処理用部材は例えば半導体製品製造におけるCVD工程で形成した二酸化珪素などの酸化膜の密着性がよく、しかも不純物元素やパーティクルによる半導体製品の汚染を起すことがなく、しかも洗浄が容易である。前記石英ガラスは石英ガラス表面に薄膜を形成し、それをHF溶液またはフッ素を含有する雰囲気などでエッチング処理することで容易に製造できる。

【図面の簡単な説明】

- 10 図1、2は、本発明の石英ガラス表面の走査電子顕微鏡2次電子像写真である。

【図1】

図面代用写真



BEST AVAILABLE COPY

(5)

特開平11-106225

【図2】

図面代用写真

